

a 2020 0054

Invenția se referă la optoelectronică, în particular la fotodetectoare de radiație infraroșie.

Fotodetectorul de radiație infraroșie include un nanofir de GaAs și contacte metalice. Totodată, nanofirul este fabricat prin anodizarea unei plachete de GaAs, iar la capetele nanofirului sunt formate contacte ohmice de Cr/Au prin depunere cu utilizarea litografiei cu fascicul laser.

Revendicări: 1

Figuri: 4